Solid State Drive

SAMSUNG SSD 850 EVO Starter-Kit

Einfach Umrüsten auf hohe Alltags-Performance und herausragende Garantie mit dem smarten Starter-Kit



Highlights

SAMSUNG SSDs der 850 EVO Serie bestechen durch hohe Performance und Zuverlässigkeit sowie 5 Jahre Garantie. Die SAMSUNG SSD 850 EVO gibt es auch als praktisches Starter-Kit, in dem das notwendige Installationszubehör für Notebooks gleich enthalten ist. Dank der kostenlosen Migrationssoftware überspielen Sie eine vorhandene Windows-Installation im Handumdrehen auf Ihre neue Samsung SSD, bauen diese anstelle Ihres alten Laufwerks anschließend ein – und Ihr System fühlt sich an wie neu! Probieren Sie es.

Die SAMSUNG SSDs der 850 EVO Serie repräsentieren inzwischen die fünfte Produktgeneration. Kapazitäten von bis zu 2 TB, hohe Performance bis 540 MB/s sowie bis zu 98.000 IOPS pro Sekunde und die vorbildliche 5-Jahres-Garantie inklusive kostenloser Upgrade- und Wartungssoftware bieten als Paketlösung ein starkes Preis-Leistungsverhältnis.

Die verbliebene Hürde für den Umstieg von Festplatte auf SSD ist oft eine Neuinstallation von Windows und der Umbau der Laufwerke. Damit das möglichst einfach von der Hand geht und auch von weniger routinierten Anwendern erfolgreich durchgeführt werden kann, bietet Samsung Starter-Kits der 850 EVO Laufwerke mit 120 GB, 250 GB und 500 GB Kapazität. Diese beinhalten neben der Samsung Migrationsoftware zum Umzug einer Windows-Installation auf die Samsung SSD auch die Wartungssoftware Magician. Dazu gibt es zusätzlich einen Abstandshalter und einen SATA-zu-USB-3.0-Adapter: Über diesen schließen Sie die neue Samsung SSD extern per USB 3.0 oder USB 2.0 an, führen den Systemumzug über die Migration Software durch und bauen die SSD schließlich anstelle der Festplatte ein – fertig!











Technische Daten

	SAMSUNG .			
	Solve Share Draw	MZ-75E120RW	MZ-75E250RW	MZ-75E500RW
	Kapazität	120 GB	250 GB	500 GB
Allgemein	Gewicht	39 g	40 g	45 g
	Maße (L x B x H)	100 x 69,85 x 6,8 mm	100 x 69,85 x 6,8 mm	100 x 69,85 x 6,8 mm
Geschwindigkeit	Lesen/Schreiben	bis zu 540 MB/s¹ bzw. 520 MB/s¹	bis zu 540 MB/s¹ bzw. 520 MB/s¹	bis zu 540 MB/s¹ bzw. 520 MB/s¹
	Ein-/Ausgabeoperationen	bis zu 94.000 IOPS Read¹ bis zu 88.000 IOPS Write¹	bis zu 97.000 IOPS Read¹ bis zu 88.000 IOPS Write¹	bis zu 98.000 IOPS Read¹ bis zu 88.000 IOPS Write¹
Lieferumfang	Software	Samsung Magician Software zur Verwaltung der SSD, Samsung Data Migration (als kostenfreier Download enthalten) ²	Samsung Magician Software zur Verwaltung der SSD, Samsung Data Migration (als kostenfreier Download enthalten) ²	Samsung Magician Software zur Verwaltung der SSD, Samsung Data Migration (als kostenfreier Download enthalten) ²
	Dokumente	Installationsanweisung, Gebrauchsanleitung	Installationsanweisung, Gebrauchsanleitung	Installationsanweisung, Gebrauchsanleitung
	Installationszubehör	SATA-zu-USB 3.0-Adapterkabel, Abstandshalter	SATA-zu-USB 3.0-Adapterkabel, Abstandshalter	SATA-zu-USB 3.0-Adapterkabel, Abstandshalter

Technische Merkmale der SSD 850 EVO Serie

Formfaktor	mfaktor 2,5 Zoll		AES 256-Bit-Verschlüsselung (Class 0), TCG/Opal 2.0, IEEE 1667 (Encrypted Drive)	
Durchschnittliche Leistungs- aufnahme im Betrieb ³	Lesen: max. 3,7 W (2 TB) Schreiben: max. 4,7 W (2 TB)		SAMSUNG 256 MB Low Power DDR3 SDRAM (120 GB) SAMSUNG 512 MB Low Power DDR3 SDRAM	
Durchschnittliche Leistungs- aufnahme im Leerlauf ³	Leerlauf: max. 0,05 W Ruhezustand (DevSlp): 0,002 W (120 GB, 250 GB, 500 GB) bzw. 0,004 W (1 TB) und 0,005 W (2 TB)	DRAM Cache-Speicher	(250 GB/500 GB) SAMSUNG 1 GB Low Power DDR3 SDRAM (1 TB) SAMSUNG 2 GB Low Power DDR3 SDRAM (2 TB)	
Zulässige Spannung 5 V ± 5 %			Sequential Read: max. 540 MB/s	
Zuverlässigkeit (MTBF)	1,5 Mio. Stunden		Sequential Write: max. 520 MB/s 4 KB Random Read (QD1): max. 10.000 IOPS 4 KB Random Write (QD1): max. 40.000 IOPS 4 KB Random Read (QD32): max. 94.000 IOPS (120 GE 4 KB Random Read (QD32): max. 97.000 IOPS (250 GE 4 KB Random Read (QD32): max. 98.000 IOPS (500 GB/1 TB/2 TB) 4 KB Random Write (QD32): max. 88.000 IOPS (120 GB/250 GB/500 GB) 4 KB Random Write (QD32): max. 90.000 IOPS (1 TB/2 TB)	
Betriebstemperatur	0 °C bis 70 °C	Performance ¹		
Lebensdauer	75 TB Total Bytes Written bei 120 GB und 250 GB 150 TB Total Bytes Written bei 500 GB/1 TB und 2 TB	Constitution		
Schnittstelle	SATA 6 Gb/s (abwärtskompatibel mit SATA 3 Gb/s und SATA 1,5 Gb/s)			
Stoßsicherheit	1.500 G und 0,5 ms (halber Sinus)	Besonderheiten	GC (Garbage Collection), TRIM, SMART, TurboWrite-Technologie	
Storage-Speicher	Samsung 3-Bit V-NAND		5 Jahre eingeschränkte Garantie (150 TB TBW bei 500 GB/1 TB und 2 TB, 75 TB TBW bei 250 GB und 120 GB)	
Controller	Samsung MGX-Controller (120/250/500 GB, 1 TB) Samsung MHX-Controller (2 TB)	Garantie		
		· -		

 $^{^1} Sequenzielle \ Leistungsdaten \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random-Performance \ ermittelt \ mit \ Crystal Disk Mark \ v3.0.1. \ Random Performance \ ermittel$ lometer 2010. Performance variiert in Abhängigkeit von SSD Firmware, Systemhardware und -konfiguration.

² www.samsung.com/samsungssd

³ Die tatsächliche Leistungsaufnahme kann abhängig von der Systemhardware und -konfiguration abweichen.

